ペルオキシ二硫酸イオン ($S_2O_8^{2-}$) 含有電解液における GaN の電気化学特性

Electrochemical properties on GaN electrode in $S_2O_8^{2-}$ containing electrolytes

北大量集センター¹、サイオクス²

○渡久地 政周¹、三輪 和希¹、堀切 文正²、福原 昇²、成田 好伸²、吉田 丈洋²、佐藤 威友¹

RCIQE, Hokkaido Univ.¹, SCIOCS Co. Ltd.²

○M. Toguchi¹, K. Miwa¹, F. Horikiri², N. Fukuhara², Y. Narita², T. Yoshida², and T. Sato¹

E-mail: toguchi@rciqe.hokudai.ac.jp

1. はじめに

半導体のウェットエッチングでは、適切な酸化剤の選択とベース溶液（酸・アルカリ）の混合比が、エッチング速度や平坦性に大きな影響を与える。ペルオキシ二硫酸イオン ($S_2O_8^{2-}$) は、過酸化水素 (H_2O_2) と比べてより強い酸化剤として作用し[1]、窒化ガリウム (GaN) に対してもその有効性が報告されている[2]。この系において、 $S_2O_8^{2-}$ イオンの還元あるいは光励起 ($\lambda < 310\text{nm}$) により生成する硫酸イオンラジカル ($SO_4^{\cdot-}$) は、GaN 表面の直接酸化に利用されることもあり、その濃度制御は重要である。本研究では、GaN のウェットエッチングにおける $S_2O_8^{2-}$ イオンと $SO_4^{\cdot-}$ ラジカルの働きを明らかにすることを目的とし、GaN 電極の電気化学特性を調査した。

2. 実験方法

n 型 GaN 基板の上に MOVPE 結晶成長した n-GaN 層 ($N_D = 5 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$) を、電気化学測定用の GaN 電極として用いた。電解液として 0.01 M の水酸化カリウム (KOH) 水溶液 [電解液 A] と、0.01 M KOH に 0.05 M $K_2S_2O_8$ 水溶液を 1:1 の割合で混合した溶液 [電解液 B] の 2 種類を用いた。容量-電圧 (C-V) 測定から、GaN のフラットバンド電位 (V_{fb} vs. Ag/AgCl) を評価した。また、 $S_2O_8^{2-}$ イオンの添加の有無によるキャリア輸送過程の変化を、電流-電圧 (I-V) 測定により評価した。

3. 結果および考察

n-GaN と溶液を接触させると、接触電位差により電位障壁が形成される (Fig.1)。C-V 測定の結果、[電解液 A] (pH=11.6) および[電解液 B] (pH=11.4) との接触により発生する V_{fb} vs. Ag/AgCl は、それぞれ 1.29V と 1.24V であった。2つの電解液中で測定した n-GaN 電極の I-V 特性 ($\log I$ -V プロット) を、Fig.2 に比較して示す。どちらの電解液中でも、n-GaN 障壁に起因する整流性が観測された。[電解液 B] において dark で観測される順方向電流は、[電解液 A] と比較して 1~2 桁増大した。また、立ち上がり電圧が低バイアス側へシフトし、2段階の還元反応が観測された。これは、[電解液 B] の $S_2O_8^{2-}$ イオンが電子受容体として働き、水の還元反応[①]に加えて $S_2O_8^{2-}$ イオンの還元反応[②]が付与されたためである (Fig.1 反応式)。また、どちらの電解液においても、光照射の有無で順方向電流の値は変化しなかったが、平衡電位より正側 ($V > -1.0\text{V}$) で電流の増大 (光電流) が観測された。また [電解液 B] では、照射光波長: $\lambda = 250\text{nm}$ で得られる光電流値は、 $\lambda = 360\text{nm}$ と比べて大きく減少することが分かった。[電解液 B] 中の $S_2O_8^{2-}$ イオンが UVC 光を吸収し、 $SO_4^{\cdot-}$ ラジカル濃度が増大したことが示唆される。

【謝辞】本研究は JSPS 科研費 JP16H06421, JP17H03224 の助成を受けたものです。

[1] R. Memming, *J. Electrochem. Soc.*, **116**, 785 (1969).

[2] J. A. Bardwell et al., *J. Appl. Phys.* **89**, 4142 (2001).

Fig.1. Band diagram of n-GaN contacted with KOH + $K_2S_2O_8$ electrolyte.

Fig.2. $\log I$ -V plots of n-GaN electrode measured in [A] KOH and [B] KOH+ $K_2S_2O_8$.